

Сведения и публикации о ведущей организации
по диссертационной работе Терешкина Евгения Валентиновича
на тему «Обращенные гетероструктуры с донорно – акцепторным
легированием и цифровыми барьерами для увеличения коэффициента усиления
полевых транзисторов миллиметрового диапазона длин волн»
по специальности 2.2.2 – «Электронная компонентная база микро –
и наноэлектроники, квантовых устройств»
на соискание учёной степени кандидата технических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное научное учреждение Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники имени В.Г. Мокерова Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИСВЧПЭ РАН
Ведомственная принадлежность	НИЦ «Курчатовский институт»
Почтовый индекс, адрес организации	117105, г. Москва, Нагорный проезд, дом 7, строение 5.
Веб-сайт	https://isvch.ru/
Телефон	8 (495) 280-75-48
Адрес электронной почты	isvch@isvch.ru
Основные публикации по профилю оппонируемой диссертации за последние 5 лет	
<p>1. Активная копланарная линия передач на основе двухбарьерных GaAs/AlAs резонансно-туннельных диодов / А.С. Соболев, А.Ю. Павлов, М.В. Майтама [и др.] // Письма в Журнал технической физики. – 2023. – Т. 49, №2. – С. 14-16. – DOI 10.21883/PJTF.2023.02.54279.19395/ - EDN NTZLNA.</p> <p>2. Развитие технологий СВЧ электроники в ИСВЧПЭ РАН на современном этапе / Д. Л. Гнатюк, А. С. Бугаев, Р. Р. Галиев [и др.] // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2022. – Т. 1. – С. 79-83. – EDN OLSZDH.</p> <p>3. Методы сборки «система-в-корпусе» в миллиметровом диапазоне длин волн: структуры и материалы. Обзор / А. П. Лисицкий, П. П. Мальцев, О. С. Матвеевко [и др.] // Нано- и микросистемная техника. – 2022. – Т. 24, № 1. – С. 30-50. – DOI 10.17587/nmst.24.30-50. – EDN RAWENK.</p> <p>4. Разработка монолитных интегральных схем на гетероструктурах нитрида галлия / С. А. Гамкрелидзе, Д. Л. Гнатюк, О. С. Матвеевко [и др.] // Нано- и микросистемная техника. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 55-66. – DOI 10.17587/nmst.24.55-66. – EDN PMDIBN.</p> <p>5. Монолитные интегральные схемы на HEMT GaN для СВЧ-модуля с выходной мощностью 2,5 Вт и усилением 30 дБм в X-диапазоне / С. А. Гамкрелидзе, Д. Л. Гнатюк, Н. В. Зенченко [и др.] // Электронная техника. Серия</p>	

1: СВЧ-техника. – 2021. – № 4(551). – С. 25-34. – EDN DQCFZI.

6. Каскодная монолитная интегральная схема малошумящего усилителя в диапазоне частот 8-12 ГГц на наногетероструктуре нитрида галлия / С. А. Гамкредидзе, П. П. Мальцев, Ю. В. Федоров [и др.] // Нано- и микросистемная техника. – 2020. – Т. 22, № 2. – С. 98-102. – DOI 10.17587/nmst.22.98-102. – EDN IMGTVZ.

7. Обзор перспективных монолитных интегральных схем усилителей на нитриде галлия для диапазона частот 80...100 ГГц / Д. Л. Гнатюк, С. Л. Крапухина, А. П. Лисицкий, П. П. Мальцев // Нано- и микросистемная техника. – 2020. – Т. 22, № 4. – С. 227-240. – DOI 10.17587/nmst.22.227-240. – EDN GTTEDK.

8. Пути создания приемопередающих модулей для диапазона частот 57-67 ГГц / Д. В. Крапухин, Д. Л. Гнатюк, Н. В. Зенченко [и др.] // Актуальные проблемы и перспективы развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем" "РАДИОИНФОКОМ-2019" : Сборник научных статей - IV Международной научно-практической конференции, Москва, 11–15 ноября 2019 года. – Москва: МИРЭА - Российский технологический университет, 2019. – С. 60-66. – EDN VEXRRG.

9. Макетирование приемо-передающих модулей 5-миллиметрового диапазона длин волн на базе отечественных монолитных интегральных схем на нитриде галлия / Ю. В. Федоров, А. С. Бугаев, Д. Л. Гнатюк [и др.] // Нано- и микросистемная техника. – 2019. – Т. 21, № 12. – С. 702-708. – DOI 10.17587/nmst.21.702-708. – EDN RNHYKW.

10. Гнатюк, Д. Л. На пути к созданию отечественных приемо-передающих модулей V-диапазона на гетероструктурах нитрида галлия / Д. Л. Гнатюк // Электроника и микроэлектроника СВЧ. – 2019. – Т. 1. – С. 229-233. – EDN TNVXLI.

Директор ИСВЧПЭ РАН
д.т.н., профессор



С.А. Гамкредидзе